



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
университет «Московский институт
электронной техники»

Шокина пл., д.1, г.Зеленоград, Москва, 124498

Тел.: +7(499) 731 44 41 Факс: +7(499) 710 22 33

E-mail: netadm@miet.ru <http://www.miet.ru>

ОГРН 1027739615584

14.05.2025 № 94-2087/4-8
на № _____

Председателю Диссертационного совета
24.2.392.01 на базе ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»
д.ф.-м.н., проф. В.М. Аникину

СОГЛАСИЕ ведущей организации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» даёт своё согласие выступить в качестве ведущей (оппонирующей) организации по диссертации Соломатина Максима Андреевича «Высокочувствительные и высокоселективные газоаналитические однокристалльные мультисенсорные линейки на основе наноразмерных оксидных материалов», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 2.2.2. – Электронная компонентная база микро- и нанoeлектроники, квантовых устройств, поданной в диссертационный совет 24.2.392.01, созданный при ФГБОУ ВО Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.

Сведения о ведущей организации

Полное и сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» НИУ МИЭТ
Место нахождения	Россия, Москва, Зеленоград
Почтовый адрес	124498, Россия, Москва, Зеленоград, Площадь Шокина, дом 1
Телефон / факс	+7 499 731-44-41 / +7 499 710-22-33
Адрес электронной почты	netadm@miec.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет»	https://miet.ru

002289

Список основных публикаций сотрудников ведущей организации по теме диссертации соискателя в рецензируемых научных изданиях за последние пять лет:

1. Cylindrical laser beams for a-Ge₂Sb₂Te₅ thin film modification / M. P. Smayev, P. A. Smirnov, I. A. Budagovsk et al // Journal of Non-Crystalline Solids. – 2024. – V. 633. – 122952.
2. On the laser formation of suspended graphene channels of photodetectors / N. P. Nekrasov, D. T. Murashko, P. N. Vasilevsky et al // Semiconductors. – 2024. – V. 58. – I. 13. – P. 1109-1113.
3. Ионно-плазменный метод модификации слоя на основе поликристаллической алмазной пленки / З. М. Хамдохов, З. Ч. Маргушев, З. Х. Калажоков и др. // Труды Московского физико-технического института. – 2024. – Т. 16. – В. 3. – С. 133-139.
4. Conductivity Switching in Lateral Channels Based on MXene Ti₃C₂T_x / N. V. Yakunina, N. P. Nekrasov, V. K. Nevolin et al // Russian Microelectronics. – 2023. – V. 52. – I. 7. – P. 621-624.
5. Features of the formation of suspended graphene structures over an array of micro-sized pores / K. A. Tsarik, N. P. Nekrasov, V. K. Nevolin et al // Russian Microelectronics. – 2023. – V. 52. – I. 7. – P. 567-571.
6. Царик, К. А. Аналитический обзор методов получения вжигаемых и невжигаемых омических контактов к наногетероструктурам на основе нитрида галлия / К. А. Царик, А. В. Неженцев // Наноиндустрия. – 2023. – Т. 16. – В. 2. – С. 114-123.
7. Царик, К. А. Особенности конструкции гетероструктур при построении GaN нормально закрытых транзисторов для силовых монолитных интегральных схем / К. А. Царик, О. Б. Чуканова, Е. А. Козловская // Наноиндустрия. – 2023. – Т. 16. – В. 1. – С. 70-80.
8. Crystallization of GST225 thin film induced by a single femtosecond laser pulse: Experimental and theoretical study / T. Kunkel, Y. Vorobyov, M. Smayev et al // Materials Science in Semiconductor Processing. – 2022. – V. 139. – 106350.
9. Царик, К. А. Focused-ion-beam exposure of an ultrathin electron-beam resist for the formation of nanoscale field-effect transistor contacts / К. А. Царик // Semiconductors. – 2022. – Т. 56. – В. 13. – С. 444-449.
10. Чуканова, О. Б. Исследование влияния параметров структуры на выходные характеристики GaN-On-Si нормально закрытых транзисторов / О. Б. Чуканова, К. А. Царик // Электронные информационные системы. – 2022. – В. 5. – С. 14-21.
11. Использование сверхвысокоомных эпитаксиальных структур кремния диаметром до 150 мм для роста Ga(Al)N-соединений методом моГФЭ / С. Д. Федотов, В. В. Лундин, Е. Е. Заварин и др. // Наноиндустрия. – 2021. – Т. 14. – В. S7. – С. 197-200.
12. Individual SWCNT transistor with photosensitive planar junction induced by two-photon oxidation / A. V. Emelianov, N. P. Nekrasov, M. V. Moskotin et al // Advanced Electronic Materials. – 2021. – V. 7. – I. 3. – 2000872.
13. Аммиачная молекулярно-лучевая эпитаксия зародышевого смачивающего слоя AlN на виртуальных подложках 3C-SiC/Si / С. Д. Федотов, К. А. Царик, А. В. Бабаев и др. // Электроника и микроэлектроника СВЧ. – 2020. – Т. 1. – С. 10-14.

Проректор по научной работе,
К.Т.Н.




Дронов А.А.